

[4] Гольдман М. Спиновая температура и ЯМР в твердых телах. М.: Мир, 1972. 342 с.
[5] Родак М. И. ФТТ, 1964, т. 6, № 2, с. 521—527.

Казанский государственный
университет им. В. И. Ульянова-Ленина
Казань

Поступило в Редакцию
14 июля 1987 г.

УДК 539.21.535.343

Физика твердого тела, том 30, ч. 1, 1988
Solid State Physics, vol. 30, № 1, 1988

РОЛЬ ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА В ОБРАЗОВАНИИ ЛОКАЛЬНЫХ ЭКСИТОННЫХ СОСТОЯНИЙ В КРИСТАЛЛЕ НАФТАЛИНА

И. В. Бровченко, Н. И. Остапенко, М. Т. Шпак

Введение примеси в некоторых случаях приводит к образованию локальных экситонных состояний в молекулярных кристаллах. Такие состояния проявляются в виде дополнительных серий полос в спектрах поглощения и люминесценции, смещенных относительно соответствующих серий в спектрах чистого кристалла [1]. Появление локальных экситонных состояний связано с изменением межмолекулярного взаимодействия вблизи молекул примеси. Однако до сих пор неизвестно, какими именно свойствами примесной молекулы определяются условия возникновения полос локальных экситонов и их положение в спектре. Выяснению этого вопроса и посвящена данная работа.

Проведено исследование оптических спектров поглощения и люминесценции примесных кристаллов нафталина в области первого синглетного перехода. В качестве примесей было использовано 50 различных соединений (ароматические и гетероциклические соединения). Для 30 примесных систем обнаружено появление полос локальных экситонов.

На рис. 1 приведен начальный участок спектра поглощения кристалла нафталина с примесью антрацена. Здесь A и B — компоненты давыдовского расщепления чисто электронного перехода; M и D — одночастичная и двухчастичная вибронные полосы, соответствующие переходам с участием неполносимметричного колебания соответственно в возбужденном и основном ($\omega_0=509 \text{ см}^{-1}$); вибронная A' — полоса ($\nu_{A'}=31\,920 \text{ см}^{-1}$) по своим параметрам (поляризация, интенсивность, полуширина) подобна экситонной A -полосе (в [2] предполагалось, что эта полоса является a -компонентой вибронного перехода с участием полносимметричного колебания ($\omega_0=512 \text{ см}^{-1}$)). Введение примеси приводит к появлению в спектре поглощения кристалла электронных и вибронных полос локальных экситонов — L и L' (в отдельных случаях одна примесь приводит к появлению нескольких L - и L' -полос). Для всех исследованных нами примесных систем появление локальной L -полосы с длинноволновой стороны от A -полосы всегда сопровождается появлением локальной L' -полосы с длинноволновой стороны от A' -полосы, причем приблизительно на таком же расстоянии. В тех случаях, когда L' -полоса наблюдается с коротковолновой стороны от A' -полосы, в области чисто электронного перехода L -полоса не наблюдается.

Анализ полученных результатов показал явную зависимость положения локальных полос от потенциала ионизации молекул примеси. В то же время не обнаружена зависимость положения локальных полос от таких характеристик примесных молекул, как дипольный момент, поляризуемость, симметрия, наличие или отсутствие гетероатомов или заместителей, положение синглетных или триплетных уровней.

На рис. 2 приведены зависимости положений локальных L' -полос от потенциала ионизации молекулы примеси для двух рядов примесных моле-

кул: 1 — ароматические молекулы — производные бензола, нафтилина, антрацен, нафтацен; 2 — гетероциклические молекулы — производные тиофена.

Полученные экспериментальные закономерности свидетельствуют о том, что образование локальных экситонных состояний определяется преимущественно взаимодействием с переносом заряда между молекулами кристалла и примеси, причем молекула нафтилина является акцептором, а молекула примеси — донором электрона. С этим согласуется тот факт, что для производных тиофена это взаимодействие сильнее, чем для ароматических молекул ряда 1 (рис. 2), поскольку производные тиофена характеризуются более высокой электронной плотностью молекулярных π -орбиталей. Разброс точек на полученных зависимостях связан, по-видимому, главным образом с различием в строении донорных орбиталей примесных молекул.

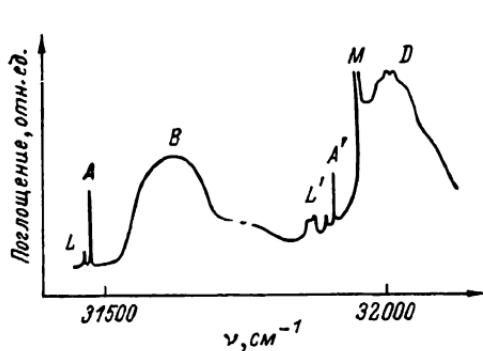


Рис. 1. Начальный участок спектра поглощения кристалла нафтилина с примесью антрацена ($C=1\%$, 4.2 К).

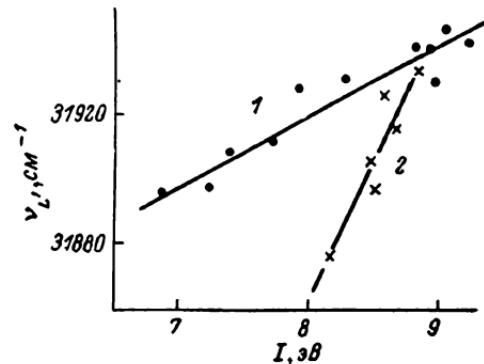


Рис. 2. Зависимость положений локальных L^1 -полос от потенциала ионизации молекул примеси.

Важно отметить, что на зависимости для ряда ароматических молекул (1, рис. 2) потенциальному ионизации молекулы нафтилина (8.12 эВ) приблизительно соответствует положение A' -полосы. Аналогично в чисто электронной области для этого ряда наблюдается следующая закономерность: локальная L -полоса появляется с длинноволновой стороны от A -полосы только в том случае, когда потенциал ионизации молекулы примеси меньше потенциала ионизации молекулы нафтилина.

Известно [3], что для рассматриваемого слабого синглетного перехода существенным является конфигурационное смешивание с состояниями с переносом заряда (СТ-состояниями). Замещение молекулы нафтилина молекулой примеси приводит к изменению энергий СТ-состояний кристалла (такое изменение будет в первую очередь связано с отличием потенциалов ионизации молекул кристалла и примеси). В результате меняется конфигурационное смешивание СТ-состояний с исследуемым синглетным состоянием, что может приводить к появлению полос локальных экситонов.

Таким образом, результаты этой работы свидетельствуют о том, что исследование локальных экситонных состояний может служить источником важной информации как об экситонных зонах, так и о состояниях с переносом заряда в молекулярных кристаллах.

Авторы выражают благодарность Э. И. Рашба за обсуждение результатов работы.

Л и т е р а т у р а

- [1] Остапенко Н. И., Сугаков Б. И., Шпак М. Т. В сб.: Экситоны в молекулярных кристаллах. Киев: Наукова думка, 1973, с. 92—140.
- [2] Остапенко Н. И., Черноморец М. П., Шпак М. Т. УФЖ, 1976, т. 21, № 2, с. 272—275.
- [3] Silbey R., Jortner J., Vala M. T., Rice S. A. J. Chem. Phys., 1965, vol. 42, N 8, p. 2948—2959.